

半 导 体 学 报

第 10 卷 第 12 期 1989 年 12 月

目 录

✓ InP δ 掺杂的输运特性 程文超 A. Zrenner 叶秋怡 F. Koch (885)
折射率缓变波导层分别限制单量子阱半导体激光器的模式分析.....
.....郭长志 陈水莲 (892)

✓ 新生界面陷阱对 Fowler-Nordheim 电压漂移的影响
.....谭长华 许铭真 王阳元 (904)

✓ 热退火对分子束外生长的高纯 GaAs 薄膜中深能级的影响
.....徐鸿达 T. G. Andersson (912)

✓ LEC GaAs 中缺陷的光致发光研究
.....陈廷杰 吴灵犀 王占国 何宏家 林兰英 (917)

Pd/a-Si:H 界面的光电子能谱研究.....
.....赵特秀 沈 波 刘洪图 季明荣 吴建新 许振嘉 (924)

半导体 3-D 磁敏器件的设计与分析 刘 亿 赖宗声 (930)

具有单元自动生成的多元胞布图方法..... 蒋君伟 唐璞山 (936)

高纯气体中痕量金属杂质的测定..... 崔仙航 徐学敏 严性天 郎文卉 (945)

研究简报

✓ 硅中 Mo-B 络合物的电荷分布 吴汲安 周 洁 张大仁 (952)

重掺 III-V 族化合物半导体载流子浓度的光测法研究.....
.....徐谨民 邵丽影 吴 敏 (955)

研究快报

✓ 硅衬底上 GaAlAs/GaAs 单量子阱激光器.....
.....庄婉如 石志文 杨培生 梅野正義 神保孝志 曾我哲夫 (960)